## Transistor Mosfet Y60NK30Z

Codigo: 112876



## Descripción

Símbolo Parámetro Valor Unidad

- VDS Tensión de fuente de drenaje (VGS = 0) 200 V
- VDGR Voltaje de compuerta de drenaje (RGS = 20 k?) 200 V
- Voltaje de fuente de puerta VGS ± 30 V
- Corriente de drenaje ID (continua) a Tc = 25 o C 60 A
- Corriente de drenaje ID (continua) a Tc = 100 oC 40 A
- IDM (•) Corriente de drenaje (pulsada) 240 A
- Disipación total de Ptot a Tc = 25 o
  C 300 W
- Factor de reducción 2,4 W / o C
- Temperatura de almacenamiento Tstg -65 a 150 o C
- Tj Max. Temperatura de unión operativa 150 o C
- (•) Ancho de pulso limitado por área de operación segura 1/4